



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H928S

对应国外型号
KSA928A

主要用途

作音频放大。

外形图及引脚排列

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度..... -55~150

T_j ——结温..... 150

P_C ——集电极耗散功率..... 750mW

V_{CBO} ——集电极—基极电压..... -30V

V_{CEO} ——集电极—发射极电压..... -30V

V_{EBO} ——发射极—基极电压..... -5V

I_C ——集电极电流..... -2A



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-30			V	$I_C=-100\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-30			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-1mA, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{CB}=-30V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{EB}=-5V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	100		320		$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-2	V	$I_C=-1.5A, I_B=-30mA$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			-1	V	$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
f_T	特征频率		120		MHz	$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$
C_{ob}	共基极输出电容		48		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

分档及其标志

0	Y
100—200	160—320